

第12回 Cat-CVD 研究会 プログラム

日時: 2015年7月3日(金), 4日(土)

場所: 名古屋大学 ES 総合館 ES 会議室

7月3日(金)

12:30-13:00 研究会受付

13:00-13:05 開会挨拶

13:05-14:05 招待講演

S01 炭素繊維強化プラスチック(CFRP)の適用の航空・自動車に対する適用の現状と動向

石川隆司 (名古屋大学)

(14:05-14:15 休憩)

14:15-15:15 一般講演

OP-01 14:15-14:30 低圧下で生成した原子状水素を用いたレジストの除去

山本雅史^{*(1)}, 梅本宏信^(2,3), 大平圭介⁽⁴⁾, 鹿間共一⁽¹⁾, 長岡史郎⁽¹⁾, 西山聖⁽⁵⁾, 堀邊英夫⁽⁵⁾

(⁽¹⁾香川高等専門学校, ⁽²⁾静岡大学, ⁽³⁾科学技術振興機構, ⁽⁴⁾北陸先端科学技術大学院大学, ⁽⁵⁾大阪市立大学)

OP-02 14:30-14:45 Cat-doping 法を用いた a-Si 膜への B および P のドーピング

瀬戸純一^{*(1,2)}, 大平圭介^(1,2), 松村英樹^(1,2)

(⁽¹⁾北陸先端科学技術大学院大学, ⁽²⁾JST CREST)

OP-03 14:45-15:00 加熱タングステンワイヤ表面でのホウ素化合物分解過程

梅本宏信^{*(1,2,3)}, 宮田篤^(1,3), 野島拓翔⁽²⁾

(⁽¹⁾静岡大総合科学技術研究科, ⁽²⁾静岡大工学部, ⁽³⁾JST CREST)

OP-04 15:00-15:15 HW-ALD 法による高品質ニッケル薄膜形成における NH₂ ラジカルの反応性

霜垣幸浩^{*}, 袁光傑, 清水秀治, 百瀬健

(東京大学)

15:15-15:55 招待講演

S02 硬 X 線 XAFS 測定 -- あいち SR の状況を交えて --

田淵雅夫 (名古屋大学)

(15:55-16:10 休憩)

16:10-17:40 ポスターセッション(ショートプレゼンテーションを含む)

PP-01 Si 基板上に堆積した SiCN 膜の機械的特性調査および熱処理効果の検討

山本賢宏⁽¹⁾, 山田知広^(1,2), 門谷豊⁽³⁾, 和泉亮^(1,3)

(⁽¹⁾九州工業大学大学院, ⁽²⁾福山職業能力開発短期大学校, ⁽³⁾トップマコート)

PP-02 非晶質 InGaZnO₄ の酸素化及び水素化によるバンド吸収端の特性評価

張帥澤*, 小松大介, 清水耕作

(日大生産工)

PP-03 非晶質酸化物半導体薄膜トランジスタの特性不安定性解析

竹山裕貴*, 田中聡, 大野祐貴, 清水耕作

(日大生産工)

PP-04 ラジカルを用いた表面窒化反応による HfNx 膜の低温作製

佐藤勝*, 武山真弓, 野矢厚

(北見工業大学)

PP-05 ウェハレベル Cu-Cu 真空封止接合のためのリモート型ホットワイヤ装置の開発

田中康基*, 熊野勝文, 田中秀治

(東北大学)

18:00-19:30 交流会(レストラン花の木)

7月4日(土)

9:00-9:40 招待講演

S03 結晶シリコン太陽電池の最近の動向

大下祥雄⁽¹⁾, 神岡武文⁽¹⁾, 中村京太郎⁽²⁾ (⁽¹⁾豊田工業大学, ⁽²⁾明治大学)

9:40-10:10 一般講演

OP-05 9:40-9:55 極薄酸化膜形成による a-Si 堆積時のエピタキシャル成長抑止

及川貴史⁽¹⁾, 大平圭介^(1,2), 東嶺孝一^(1,2), 松村英樹^(1,2)

(⁽¹⁾北陸先端科学技術大学院大学, ⁽²⁾JST CREST)

OP-06 9:55-10:10 変調アドミタンス法による原子状水素供給スパッタにより成膜された p-i-n 界面の評価

大江和顕*, 岩崎真宝, 清水耕作

(日大生産工)

(10:10-10:25 休憩)

10:25-11:40 一般講演

OP-07 10:25-10:40 Reduction in interface state density at the interfaces of Cat-CVD SiN_x/c-Si and SiN_x/P Cat-doped layer/c-Si structures

Trinh Cham Thi^{*(1,2)}, Koichi Koyama^(1,2), Keisuke Ohdaira^(1,2), and Hideki Matsumura^(1,2)

(⁽¹⁾ Japan Advanced Institute of Science and Technology, (⁽²⁾ JST CREST)

OP-08 10:40-10:55 SiN_x/a-Si 積層パシベーションにおける Cat-CVD 法と PECVD 法の比較

小山晃一*, 寺嶋茂樹, 東嶺孝一, 大平圭介, 松村英樹

(北陸先端科学技術大学院大学)

OP-09 10:55-11:10 室温堆積による SiN_x 膜の特性評価

武山真弓^{*(1)}, 佐藤勝⁽¹⁾, 小林靖志⁽²⁾, 中田義弘⁽²⁾, 中村友二⁽²⁾, 野矢厚⁽¹⁾

(⁽¹⁾北見工業大学, (⁽²⁾富士通研究所)

OP-10 11:10-11:25 マイクロ波表面波プラズマ CVD 法によるグラフェンの合成

市村進^{*(1,2)}, 林靖彦⁽²⁾, 梅野正義⁽¹⁾

(⁽¹⁾中部大学, (⁽²⁾岡山大学)

OP-11 11:25-11:40 傾斜面におけるカーボンナノウォールの成長

伊藤貴司*, 山本大貴, 小川大, 野々村修一

(岐阜大学)

(11:40-13:00 昼食休憩)

13:00-13:40 招待講演

S04 超臨界流体を用いた金属薄膜堆積

近藤英一 (山梨大学)

13:40-14:20 招待講演

S05 CVD の反応速度解析と量・質の予測 - 熱分解炭素 CVD を中心に -

河瀬元明 (京都大学)

(14:20-14:35 休憩)

14:35-15:35 招待講演

S06 南海トラフ巨大地震への社会の対策を誘発する

福和伸夫 (名古屋大学)

15:40-16:40 見学会(減災館)

16:40-16:50 閉会挨拶